

請求の範囲

- [請求項1] 積層されたシリコン酸化物層とシリコン窒化物層とを有する積層膜を備える被処理体を、化学式 $C_2H_xF_{(3-x)}Br$ （前記化学式中の x は0、1、又は2である）で表される不飽和ハロンを含有するエッチングガスにより処理して、前記シリコン酸化物層と前記シリコン窒化物層との両方をエッチングするエッチング工程を備えるエッチング方法。
- [請求項2] 前記不飽和ハロンがブロモトリフルオロエチレン、（E）－1－ブromo－2－フルオロエチレン、及び1－ブromo－1－フルオロエチレンからなる群より選ばれる少なくとも一つである請求項1に記載のエッチング方法。
- [請求項3] 前記エッチングガスが不活性ガスをさらに含有する請求項1又は請求項2に記載のエッチング方法。
- [請求項4] 前記エッチング工程においては、前記エッチングガスをプラズマ化して得られるプラズマガスを用いてエッチングする請求項1～3のいずれか一項に記載のエッチング方法。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれか一項に記載のエッチング方法でエッチングを行うことを含む半導体の製造方法。